PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-131520

(43) Date of publication of application: 09.05.2002

(51)Int.Cl.

G02B 5/10 G02B 7/182 G03F 7/22 H01L 21/027

(21)Application number: 2000-328094

(71)Applicant: NIKON CORP

(22) Date of filing:

27.10.2000

(72)Inventor: TAKINO HIDEO

ITO AKINORI

(54) METHOD FOR MANUFACTURING MULTI-SURFACE REFLECTION MIRROR, AND ALIGNER USING REFLECTION MIRROR

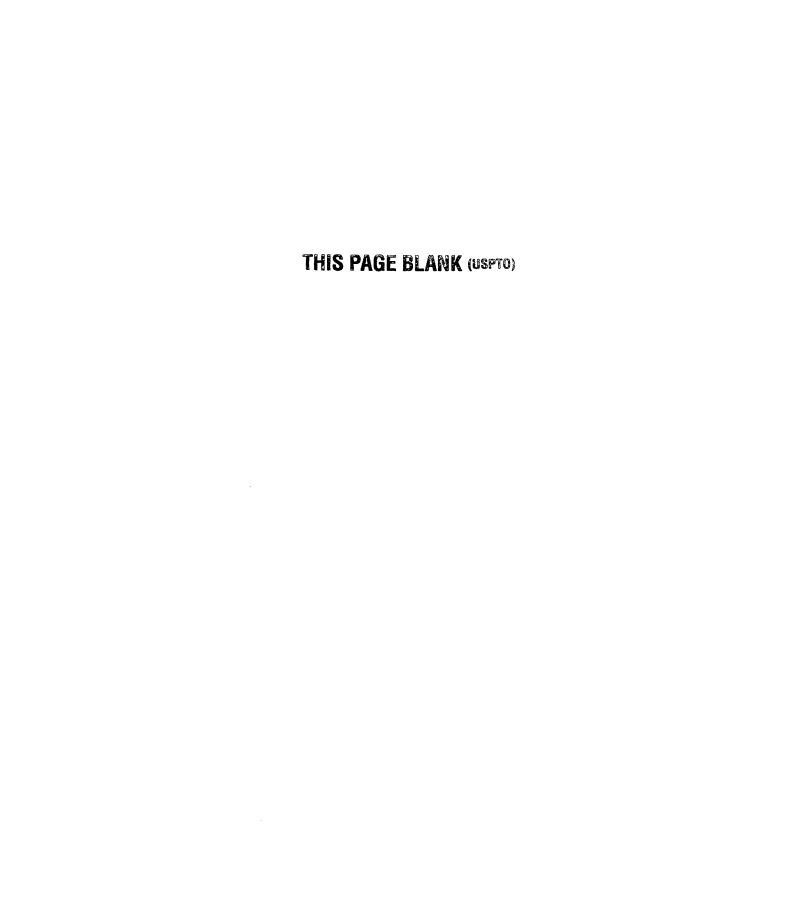
(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for manufacturing a multi-surface reflection mirror having a reflection plane shape with a high yield, and further to obtain a semiconductor aligner with higher throughput.

SOLUTION: The method for manufacturing the multisurface reflection mirror comprises repeatedly arranging a basic reflection plane, forming a part of a specified curved surface into a plane shape, on an arrangement table and consists of a first positioning part forming step to form the first positioning part on the basic reflection plane and a second positioning part forming step to form the second positioning part on the arrangement table and a contacting step to

contact the first positioning part against the second positioning part.

BEST AVAILABLE COPY



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-131520 (P2002-131520A)

(43)公開日 平成14年5月9日(2002.5.9)

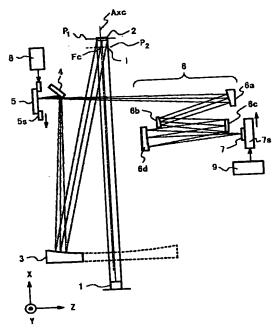
	(4D) ABI II	
(51) Int.Cl. ⁷ G 0 2 B 5/10 7/182 G 0 3 F 7/22 H 0 1 L 21/027	識別記号	FI G02B 5/10 C 2H042 G03F 7/22 H 2H043 G02B 7/18 Z 5F046 H01L 21/30 515D 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特顧2000-328094(P2000-328094) 平成12年10月27日(2000.10.27)	(71) 出願人 000004112 株式会社ニコン 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 (72)発明者 瀧野 日出雄 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 (72)発明者 伊藤 彰則 東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株 式会社ニコン内 Fターム(参考) 2H042 DC07 DC09 DC10 DD04 2H043 CA02 CA04 CA09 5F046 CB03

多面反射鏡の製造方法および反射鏡を用いた露光装置 (54) 【発明の名称】

(修正有) (57)【要約】

【課題】反射面形状を有する多面反射鏡を歩留まりよく 製造できる製造方法を提供するとともに、さらには、よ りスループットの高い半導体露光装置を得る。

【解決手段】 所定の曲面の一部を面形状とする基本反 射面を配置台に繰り返し配置してなる多面反射鏡の製造 方法であって、前記基本反射面に第1の位置決め部を形 成する第1位置決め形成工程と、前記配置台に第2の位 置決め部を形成する第2位置決め形成工程と、前記第1 の位置決め部と前記第2の位置決め部とを当接させる当 接工程とからなる多面反射鏡の製造方法とした。



10

40

1

【特許請求の範囲】

【請求項1.】所定の曲面の一部を面形状とする基本反射面を配置台に繰り返し配置してなる多面反射鏡の製造方法であって、前記基本反射面に第1の位置決め部を形成する第1位置決め形成工程と、前記配置台に第2の位置決め部を形成する第2位置決め形成工程と、前記第1の位置決め部と前記第2の位置決め部とを当接させる当接工程とからなる多面反射鏡の製造方法。

【請求項2】前記第1及び第2の位置決め部の形状は、 突起又は溝であることを特徴とする請求項1に記載の多 面反射鏡の製造方法。

【請求項3】請求項1又は2に記載の多面反射鏡の製造 方法によって製造された多面反射鏡。

【請求項4】請求項3 に記載の多面反射鏡を具えたことを特徴とする反射型照明装置。

【請求項5】光源と、マスクを保持して移動するマスクステージと、前記マスクに前記光源からの光を照明する照明装置と、前記照明装置によって照明された前記マスク上のパターンをウェハ上に投影する投影光学装置と、前記ウェハを保持して移動させるウェハステージとを有20する半導体露光装置であって、

前記照明装置が請求項4に記載の反射型照明装置である ことを特徴とする半導体露光装置。

【請求項6】前記反射型照明装置は、前記多面反射鏡の 有する反射面が前記投影光学装置の光学視野と相似形状 であることを特徴とする請求項5 に記載の半導体露光装 置。

【請求項7】前記投影光学装置の光学視野が円弧状であることを特徴とする請求項6に記載の半導体露光装置。 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、反射鏡の製造方法 及び半導体製造装置に関するものであり、特には、基本 反射面の繰り返し配列により構成される反射面を有する 多面反射鏡の製造方法、反射型照明装置、更にはその照 明装置を用いた露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在、DRAMやMCP等の半導体デバイスの製造においては、線幅をより狭くする開発研究が盛んに行われており、デザインルール 0. 13μ m (4G・DRAM相当)、0. 1μ m (16G・DRAM相当)、更には0. 07μ m (32G・DRAM相当)の実現に向けて種々の技術が開発されている。

【0003】線幅を狭くしようとすると、露光時に光の回折現象が生じるする。すなわち、線幅を狭くしようとした場合、回折現象に起因す像や集光点のボケなどが生じることが問題となる。この回折現象の影響を押さえるためには露光光学系の開口数(N.A.:Numerical aperture)を大きくする必要があり、光学系の大口径化と波長の短波長化が開発のポイントになっている。

[0004] ところが、光の波長を短く、特に200 n m以下にすると、加工が容易でありながら、光吸収の少ない光学材料が見当たらない。このため、反射光学系による投影光学系の開発がなされており、相当な成果を上げている。その中に、複数の反射鏡の組み合わせによって、軟X線に対して円弧状の光学視野(露光領域として使用出来る領域)を実現し、マスクとウェハを投影縮小率比の相対速度で、互いに同期して移動させることによってチップ全体を露光しようとする方法がある(例えば、Koichiro Hoh and Hiroshi Tanino; "Feasibility Study on the Extreme UV/Soft X-ray Projection—type

は、Koichiro Hoh and Hiroshi Tanino; "Feasibility Study on the Extreme UV/Soft X-ray Projection—type Lithography", Bulletin of the Electrontechnical Laboratory Vol. 49, No.12, P.983—990, 1985.を参照。なお、この文献を以後、参考文献1と記す)。

【0005】ところで、線幅と並ぶ重要な要素にいわゆるスループットがある。このスループットに関与する要因としては、光源の発光強度、照明系の効率、反射系に使用する反射鏡の反射率、ウェハ上の感光材料・レジストの感度等がある。現在、光源としては、ArFレーザー、F、レーザー、更に短波長光の光源としてシンクロトロン放射光やレーザーブラズマ光がある。また、これらの光を反射する反射鏡に関しても、高い反射率が得られるように多層膜反射鏡の開発も行われている(詳細は前述の参考文献1、及び、Andrew M. Hawryluk et al.

; "Soft x-raybeamsplitters and highly dispersive

multilayer mirrors for use as soft x-ray laser cav

ity component", SPIE Vol. 688 Multilayer Structure and Laboratory X-ray Laser Research (1986) P.81-90 及び、特開昭63-312640号公報を参照)。【0006】さて、この半導体露光装置用として、ムラ無く均一に原版を照明するために、光源の光量分布によらずに均一に原版に照明するための照明光学系が開発されている。この照明光学系に要求されるものは、一様照明性や開口性である。例えば特開昭60-232552号公報には、矩形形状の照明領域を対象とした技術が提案されている。しかし、半導体露光装置には、原版のバターンをウェハ上に形成する投影光学系を備えており、この投影光学系の視野が円弧上である場合、照明視野が矩形形状では光の利用効率が悪く、どうしても露光時間

【0007】また、近年、軟X線を供給するシンクロトロン発生装置等の光源装置を用いて、より一層微細な線幅のパターンを感光性基板に投影露光し得る次世代の露光装置が切望されているが、これまで軟X線等のX線を効率良く均一にマスクを照明し得る照明装置、及び露光装置が提案されていなかった。

を短縮出来ず、従って、スループットが上がらなかっ

【0008】最近、との問題を解決する方法として、投 影光学系の有する光学視野に合わせて照明視野を設定 50 し、とれによって照明効率を上げ、スループットの問題

を解決する方法が特開平11-312638号公報に提 案されている。

【0009】との方法を用いることにより、従来型より も格段に照明効率が高く、より高いスループット化にも 十分に対応でき、しかもケーラー照明等の均一照明が実 現し得る照明装置、その照明装置を備えた露光装置が実 現可能である。

【0010】との技術を図2をもとに簡単に説明する。 図2は投影露光装置の概要図であり、光源1より出た光 は提案された多面反射鏡2、コンデンサー光学素子3及 10 び反射鏡4を経てマスクステージ5 s 上に保持されたマ スク5を照明する。マスク5には、ウェハステージ7 s 上に保持されたウェハ上に描くべきバターンが反射体図 形として形成されている。マスク上のパターンは2. 3. 4からなる反射型照明光学装置によって照明され、 6 a , 6 b , 6 c , 6 d からなる投影光学装置 6 を通じ

てウェハ7上に投影される。この時投影光学装置の光学 視野は製作すべきデバイスチップ全体をカバー出来るほ ど広くはなく、マスク5とウェハ7を同期させて相対的 に移動 (スキャン) させながら露光を行うことによって チップ全体のパターンをウェハ上に形成する。このため に、ステージの移動量を制御する、レーザー干渉距離計 を含むマスクステージコントローラ8とウェハステージ コントローラ9が備わっている(このスキャンを伴う露 光方式に関しては先の参考文献 1 を参照)。 との際のポ イントは、多面反射鏡2をひとつ又は複数の微小な基本 反射面の繰り返し配列により多面反射鏡を構成すること であり、その基本反射面の外形状を投影光学装置の光学 視野形状と相似形にすることである。これによって位置 P2 に多数の点光源像 I がほぼ円形状に形成され、これ 30 がコンデンサー光学素子によって必要な照明視野を形成 する。上記のような技術によって、マスク上の照明すべ き領域を無駄無く一様に照明でき、露光時間の短縮が可 能になって、高いスループットを有する半導体露光装置 の実現が可能になる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】上記の様な、円弧状の 照明視野を有する反射型照明光学装置用の多面反射鏡、 及びその基本反射面を実際に設計した結果を図3、4を 用いて説明する。図3に示すように、この多面反射鏡 は、3種類の基本反射面(A、B、C)から構成されて いる。すなわち、多面反射鏡の各列は、各基本反射面が A、B、C、…の順に配列されている。図4(a). (b), (c)には、各基本反射面の形状を示す。これ 5の図に示すように各基本反射面は、曲率半径Rの凹の 球面41に、YZ面に平行な円弧状帯(平均半径がZh の円の円弧状帯)を投影した形状になっている。 このと き、投影する円弧の円の中心を球面の中心軸に合わせた 場合の投影像がAであり、円弧の中心を球面の軸に垂直 にYhだけずらした場合の投影像がB、Cである。この

投影像形状を切り出して基本反射面とする。いずれも、 ほぼ円弧状になる。少なくともX方向より見れば完全な 円弧状である。そして、B、CをそれぞれY軸方向に平 行移動してAと組み合わせていく。このようにしてでき た多面反射鏡に、例えばX方向より平行光線を入射させ るとAによる点像が球面41の焦点に、Bによる点像が 焦点より+Yhだけ横ずれして、Cによる点像が焦点よ ŋ-Yhだけ横ずれして形成される。ととで、例えば、 基本反射面の好適な実用的な設計解としては、凹球面の 曲率半径Rは150~2000mm、乙hは2~10m m、円弧の幅 (円弧状帯の幅) は0. 1~20mm、円 弧の長さは2~40mm、Yhは約 1~10mm であ り、更に表面粗さがRrms<0.3nmである。 【0012】ところで、上記のような多面反射鏡を加工 する場合、その表面粗さや面形状の加工精度から考え

て、まず、被加工物を第1の所定の形状を有する曲面に 仕上げておき、その曲面の所定の位置より基本反射面を 切り出す。例えば、図5に示すように、被加工物113 をワークホルダー114に保持して回転させ、バイトホ ルダ111によって保持されたダイヤモンドバイト11 **2を使ったNC切削加工機により第1の所定の曲面に形** 状創成する。この後、加工面を図6に示すように、被加 工物をワークホルダ115に保持して回転させ、研磨皿 116に貼り付けられたポリシャ117の揺動軸を揺動 させて研磨することによって必要となる表面粗さRrm s<0.3nmを満足させる。次に、本被加工物の一部 を図7に示すようなワイヤ放電加工機によって切り出 し、これを貼り合わせることによって図3のような複雑 な形状の基本反射面を有する多面反射鏡を製造すること ができる。

【0013】しかし、この基本反射鏡を組み上げる工程 は実際に光を照射して、ウエハ位置に置かれた撮像素子 上に照明視野を形成させ、この像をCRT上で観察しな がら1個づつ基本反射面の取り付け位置や角度を調節し ていた。このため、調整には膨大な時間と手間がかか り、したがってコスト高の大きな要因になっていた。ま た、人の目を介して行う作業なので調整のバラツキを避 けることができず、性能も一定していなかった。

【0014】そこで、本発明はこのような課題を解決す べく考案したものであり、設計通りの反射面形状を有す る多面反射鏡を歩留まりよく製造できる製造方法を提供 40 することを第1の目的とし、さらには、よりスループッ トの高い半導体露光装置を得ることを第2の目的として いる。

[0015]

50

【課題を解決するための手段】そとで上記の問題点を解 決するために本発明によれば、所定の曲面の一部を面形 状とする基本反射面を配置台に繰り返し配置してなる多 面反射鏡の製造方法であって、前記基本反射面に第1の 位置決め部を形成する第1位置決め形成工程と、前記配

置台に第2の位置決め部を形成する第2位置決め形成工 程と、前記第1の位置決め部と前記第2の位置決め部と を当接させる当接工程とからなる多面反射鏡の製造方法 とした。

[0016]

【発明の実施の形態】本発明では、上記のような多面反 射鏡を製作する場合、1個づつ基本反射面の取り付け位 置や角度を調節する方法には限界があること、また時間 と手間がかかるため製作費用に関してもマイナスが大き いことを考慮して、まず各々の基本反射面を設計値どお 10 示し、図8(b)は図8(a)のC-C 間の断面を示 りに製作し、そののちに、それらを正確に、安価に組み 合わせる方がより高性能な多面反射鏡を安価に得られる という考えに立脚している。

(第1の実施例) 本発明の実施例を、図面を用いて説明 する。

【0017】本実施例では、以下の形状の基本反射面を 例にとる。すなわち、光学面の凹球面の曲率半径はRは 180mm、Zhは5.0mm、円弧の幅(円弧状帯の 幅)は1.0mm、円弧の長さは5.0mm、Yhは約 2. 5 mm、円弧凸面の曲率半径は20 mm、円弧凹面 の曲率半径は20mmである。

【0018】基本反射面を有する基本反射鏡の製作には 前述のような方法が適用可能である。ことに再度記す。 基本反射鏡の素材としてアルミ合金を準備する。このア ルミ合金の一面に旋盤により曲率半径180mmの凹面 を加工する。とのときの凹面加工では、数μπの誤差が あっても良い。また、本実施例では基本反射鏡の中心の 高さが9.95mmとなるようにした。その高さは5~ 20mm程度としてもさしつかえない。さらに加工され た凹面に、無電解ニッケルメッキを厚さ100μm施し て、基本反射鏡の中心の高さを10.05mmとした。 さらに、このメッキ面を、図5に示すようにダイヤモン ドバイトを使ったNC切削加工機により、曲率半径18 0 mmの凹面を高精度に加工する。またこのときの加工 量は50 µmとすることにより、基本反射鏡の中心の高 さは10mmとした。なお、基本反射鏡の中心高さが最 終的に所望値になるのであれば、無電解ニッケルメッキ の厚さは、50μmに限られるものではなく、数10~ 数100μmでもよい。さらに凹面の形状誤差が1μm 以下になるように加工した。

【0019】つぎに、図6に示すように、NC切削加工 面を研磨して、曲率半径180mmの精度を維持したま ま、切削時のツールマークを除去する。研磨する面に は、無電解ニッケルメッキが付与されているため、必要 となる表面粗さRrms<0. 3 nmを満足させること ができる。

【0020】つぎに、本被加工物の一部を図7に示すよ うなワイヤ放電加工機により切り出す。もしくはフライ ス加工により切り出しても良い。

【0021】得られた基本反射鏡の底面の端面に、図1 50 は、図3に示した多面反射鏡を構成する各列の上端の2

に示すように切り欠きを加工する。本実施例では、切り 欠きの高さHkは、基本反射鏡の高さの40%である4 mmとした。Hkは基本反射鏡の高さの10~90%程 度でも同様の効果が得られる。切り欠き間の幅Wkは、 基本反射鏡の円弧長さの60%である3mmとした。▼ kは基本反射鏡の円弧長さの10~90%程度でも同様 の効果が得られる。このように切り欠きを加工すること により、基本反射鏡に位置決め用の突起を形成できる。 【0022】図8(a)は基本反射鏡を載置する載置台 す図である。

【0023】まず、載置台の素材として、インバーを準 備する。Α面をフライス加工により、例えば1μm程度 の高い平面度に加工する。つぎにA面に、フライス加工 により、Wg = 3mm、Lg = 5mm、Dg = 3. 9mmの溝を等間隔に5列加工する。この溝により基本反射 鏡はY軸方向に位置決めされる。Wgの長さは、基本反 射鏡のWkの長さと等しいか、基本反射鏡を容易にはめ 込むことができるくらい、例えば1~数100μm広く 20 することが望ましい。Lgの長さは、基本反射鏡の円弧 長さと等しいか、基本反射鏡を容易にはめ込むことがで きるくらい、例えば1~数100μm広くすることが望 ましい。Dgの深さは、基本反射鏡のHkの長さよりも 浅くする。本実施例では、Dgは基本反射鏡のHkより 0. 1mm浅くしているが、後述のように、隙間に接着 層を設けることができれば、この値に限られるものでは ない。また、図示のように、溝の始点はY軸と平行に加 工されており、各溝の始点の2座標は、図3に示した多 面反射鏡を構成する各列の上端の2座標と等しい。各溝 の始点のZ座標は、図3に示した多面反射鏡を構成する 各列の下端の2座標と等しくてもよい。この始点により 基本反射鏡は2軸方向に位置決めされる。

【0024】つぎに、載置台の溝に、基本反射鏡の位置 決め突起をはめ込んで接着する。接着は、図9のよう に、隙間Cに接着剤を塗布して行う。すなわち、本実施 例では、隙間Cは幅0.1mmなので、接着代も0.1 mmである。ことで、1個目に接着する基本反射鏡は、 溝の始点と密着するようにする。2個目に接着する基本 反射鏡は、1個目の基本反射鏡に密着するようにしなが 40 ら、同様に、隙間Cに接着剤を塗布して接着する。この ようにして、1~5列目に、すべての基本反射鏡を接着 することにより、多面反射鏡が形成できる。

【0025】図10(a)は基本反射鏡を載置する載置 台示し、図10(b)は図10(a)のA-A 間の断 面を示す図である。

【0026】また、各溝の始点と終点は、図10のよう に、円弧の曲率半径 (R20mm)と一致する曲率半径 を有する面(以下、B面と呼ぶ)に加工しておいても良 い。B面を凹面に加工する場合、B面の中心のZ座標

30

座標と等しくする。B面を凸面に加工する場合、B面の 中心の2座標は、図3に示した多面反射鏡を構成する各 列の下端の2座標と等しくする。 載置台の溝に、1個目 の基本反射鏡を接着する際には、B面と密着するように する。なお、載置台に直接B面を加工する代わりに、図 11に示すように、少なくとも1つの面がB面の形状を した凹部材を滯にはめ込んでも良い。または凸部材をは め込んでも良い。

【0027】上記のように接着することにより、基本反 射鏡の第1の位置決め部と載置台の第2の位置決め部と が当接するので、すべての基本反射面のX方向における 位置を一定に揃えて固定することができる。また、位置 決め突起と溝とが勘合しているので、すべての基本反射 鏡のY方向における位置決めを正確かつ容易に行うとと ができる。また、基本反射鏡を載置台に接着する際に、 基本反射鏡の円弧同士を接触させるようにしているの で、すべての基本反射鏡の2方向の位置決めを正確かつ 容易に行うことができる。

【0028】また、載置台の溝はフライス加工機で加工 するので、簡便にμπオーダの高精度で加工できる。ま た、基本反射鏡の切り欠きも、フライス加工機で加工す るのでμmオーダの高精度で加工できる。 これらは多面 反射鏡を形成するのに充分な精度である。なお、基本反 射鏡の切り欠きの加工は、基本反射鏡 1 個ずつに対して 行うのではなく、複数をならべて、まとめて加工すると 効率がよい。

【0029】以上のようにして、設計値どおりに製作し た複数の基本反射鏡を組み合わせることにより、図3に 示す多面反射鏡を効率よく高い精度に製作することがで

【0030】また、上記多面反射鏡を半導体露光装置に 組み込むためには、図2のように構成すればよい。

(第2の実施例)以下に本発明に係わる第2の実施例を 説明する。

【0031】まず、第1の実施例に記した加工法によ り、基本反射鏡を製作する。

【0032】得られた形成された基本反射鏡の低面の中 央に、図12に示すような切り欠きを加工する。本実施 例では、切り欠きの高さHkは、基本反射鏡の高さの4 0%である4mmとした。Hkは基本反射鏡の高さの1 $0\sim 90\%$ 程度でも同様の効果が得られる。切り欠きの 幅Wkは、基本反射鏡の円弧長さの60%である3mm とした。Wkは基本反射鏡の円弧長さの10~90%程 度でも同様の効果が得られる。この切り欠きが、基本反 射鏡の位置決め用の溝である。

【0033】図13(a)は基本反射鏡を載置する載置 台示し、図13 (b)は図13 (a)のC-C '間の断 面を示す図である。

【0034】まず、載置台の素材としてインバーを準備 する。A面をフライス加工により、例えば l μ m 程度の 50

高い平面度に加工する。つぎにA面に、フライス加工に より、Wg=3mm、Lg=5mm、Dg=3. 9mmの溝を6列加工する。突起間の距離が等間隔になるよう に、6列の溝を加工する。こうして形成された溝と溝の 間の凸部が要素光学素子をY軸方向に位置決めするため の突起である。Wgの長さは、基本反射鏡のWkの長さ と等しいか、基本反射鏡を容易にはめ込むことができる くらい、例えば1~数100μm広くすることが望まし い。Lgの長さは、基本反射鏡の円弧長さと等しいか、 基本反射鏡を容易にはめ込むことができるくらい、例え ば1~数100μm広くすることが望ましい。 Dgの髙 さは、基本反射鏡のHkの髙さよりも浅くする。本実施 例では、Dgは基本反射鏡のHkよりO. 1mm浅くし ているが、後述のように、隙間に接着層を設けることが できれば、この値に限られるものではない。つぎに、突 起に、図示のように、位置決め部材を固定する。固定に は、接着材を用いてもボルトを用いても良い。実施例で は位置決め部材の幅はWgと等しくしたが、この幅はWgより大きくても小さくても良い。との位置決め部材の 端面の2座標は、図3に示した多面反射鏡を構成する各 列の上端のZ座標と等しい。各溝の始点のZ座標は、図 3に示した多面反射鏡を構成する各列の下端の2座標と 等しくてもよい。との端面により基本反射鏡は2軸方向 に位置決めされる。

【0035】つぎに、載置台の突起に、基本反射鏡の位 置決め溝をはめ込んで接着する。接着は、図14のよう に、隙間Cに接着剤を塗布して行う。すなわち、本実施 例では、隙間Cは幅0.1mmなので、接着代も0.1 mmである。ことで、1個目に接着する基本反射鏡は、 位置決め部材の端面と密着するようにする。 2 個目に接 着する基本反射鏡は、 1 個目の基本反射鏡に密着するよ うにしながら、同様に、隙間Cに接着剤を塗布して接着 する。このようにして、 $1\sim$ 6列、すべてに基本反射鏡 を接着することにより、多面反射鏡が形成できる。

【0036】上記のように接着することにより、基本反 射鏡の第1の位置決め部と載置台の第2の位置決め部と が接触するので、すべての基本反射面のX方向における 位置を一定に揃えて固定することができる。また、基本 反射鏡の溝と載置台の突起とが勘合しているので、基本 反射鏡のY方向の位置決めを正確かつ容易に行うことが できる。また、基本反射鏡を載置台に接着する際に、基 本反射鏡の円弧同士を接触させているので、すべての基 本反射鏡の2方向における位置決めを正確かつ容易に行 うことができる。

[0037]また、載置台の溝はフライス加工機で加工 するので、簡便にμmオーダの高精度で加工できる。ま た、基本反射鏡の切り欠きも、フライス加工機で加工す るのでμmオーダの高精度で加工できる。 これらは多面 反射鏡を形成するのに充分な精度である。なお、この切 り欠きの加工は、基本反射鏡 1 個ずつに対して行うので はなく、複数をならべて、まとめて加工すると効率がよい。

【0038】以上のようにして、設計値どおりに製作した複数の基本反射鏡を組み合わせることにより、図3に示す多面反射鏡を高い精度に製作することができる。

【0039】また、上記多面反射鏡を半導体露光装置に 組み込むためには、図2のように構成すればよい。

【0040】以上のように本発明で製作した多面反射鏡に対して、反射率を上げるために、F,レーザを光源に使用する時のために、アルミニウム薄膜を約100nm 10の厚さに蒸着によって形成し、さらにその上に同一真空槽内にて酸化防止と反射率の維持の観点よりMgF,を数十nmの厚さに蒸着により形成した。また、軟X線領域の光(電磁波)を使用する時には、SiとMoの多層膜による多面反射鏡(前述の参考文献、1、2を参照)を形成した。

【0041】本発明では、球面の1部分である基本反射 鏡A、B、Cから構成される多面反射鏡の加工方法を示 した。しかし、本発明で加工できる光学素子はこれに限 られない。たとえば、基本反射鏡の種類は、3種類より も多くても、少なくても良い。また、基本反射鏡は非球 面の1部分であっても良い。また、多面反射鏡の大きさ および要素光学素子の大きさも、本実施例に限られるも のではない。また、基本反射鏡の総数も、本実施例に限 られるものではない。

【0042】また、上記の実施例では、基本反射鏡の素材としてアルミ合金を用いたが、鋼材や、無酸素銅、インバー、スーパーインバーを用いることもできる。また、上記の実施例では、素材に無電解ニッケルメッキを付与したが、切削・研磨後に鏡面性が良好であれば無電 30解ニッケルメッキでなくとも良い。例えば、ニッケル合金を主成分とする非晶質薄膜でよい。

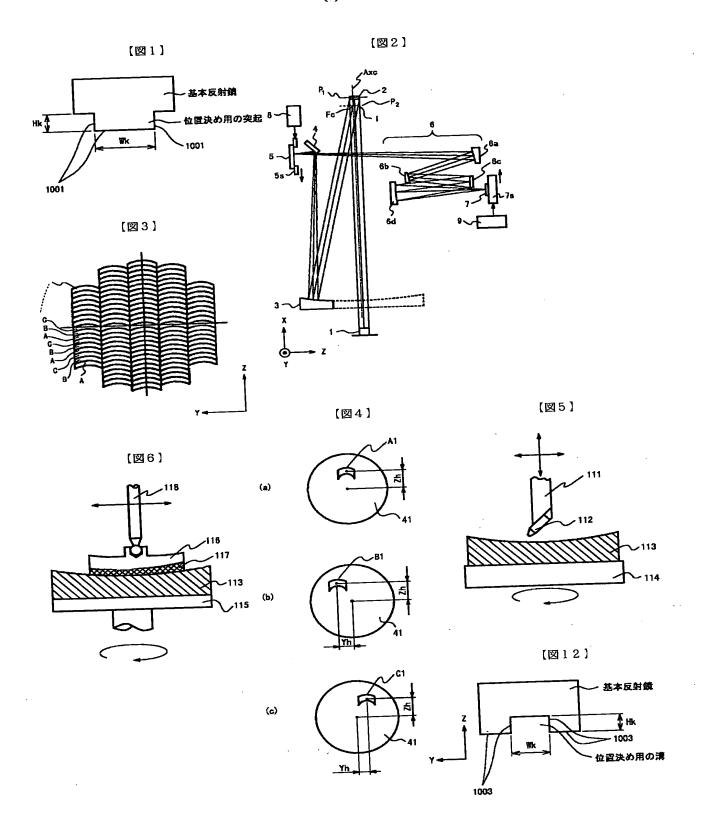
【0043】また、金属の代わりに、ガラスやシリコンを用いることもできる。この場合、無電解ニッケルメッキを付与しなくても、所望の表面粗さを得ることができる。ガラスとしては、石英ガラスや、低膨張ガラスなどを用いることができる。また、ガラスを加工する場合、基板からの切り出しは、ワイヤー放電加工の代わりに研削加工で行えばよい。また、前記切削工具の代わりに研削工具として砥石を用いればよい。シリコンを加工する40場合、ブロックからの切り出しは、ワイヤー放電加工か研削加工で行えばよい。また、前記切削工具のほかに研削工具を使うこともできる。

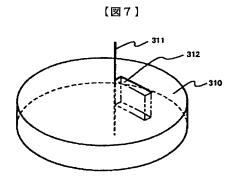
【0044】また、上記の実施例では、載置台の素材としてインバーを用いたが、鋼材、アルミ合金、無酸素銅、スーパーインバーを用いることもできる。金属の代わりに、ガラスやシリコンを用いることもできる。ガラスとしては、石英ガラスや、低膨張ガラスなどを用いることができる。また、ガラスやシリコンを加工する場合、フライス加工の代わりに研削加工で行えばよい。【0045】

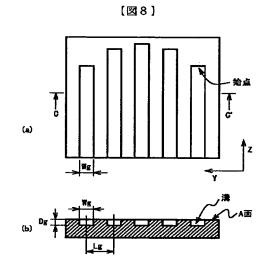
【発明の効果】上述のように、本発明によって提供される製造方法により、多数の要素反射面からなる複雑形状の光学素子を高精度で、そして、高い加工効率で製造できる。また、本製造方法により得られた多面反射鏡を露光装置用の照明装置にもちいれば、スループットの高い露光装置が得られる。

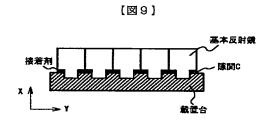
【図面の簡単な説明】

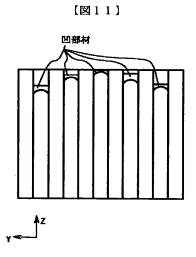
- 【図1】本発明に係わる基本反射鏡の概略図
- 【図2】多面反射鏡を使用した露光装置の光学系の概略 構成図
- 【図3】本発明に係る多面反射鏡の概略図
- 「図4】本発明に係る多面反射鏡を構成する基本反射鏡の概略図
 - 【図5】本発明の実施例に用いられる切削加工方法の概 念図
 - 【図6】本発明の実施例に用いられる研磨加工方法の概 念図
 - 【図7】本発明の実施例に用いられる基本反射鏡の切り 出し方法の概念図
 - 【図8】基本反射鏡を配列するための載置台を示す概略 図
- 【図9】載置台への基本反射鏡の載置方法を示す概略図【図10】基本反射鏡を配列するための載置台を示す概略図
 - 【図11】基本反射鏡を配列するための載置台を示す概略図
 - 【図12】本発明に係わる基本反射鏡の概略図
 - 【図13】基本反射鏡を配列するための載置台を示す概 略図
 - 【図14】載置台への基本反射鏡の載置方法を示す概略 図
- 40 【符号の説明】
 - 1001、1003…第1の位置決め部
 - 1002, 1004…第2の位置決め部

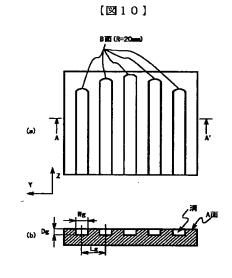


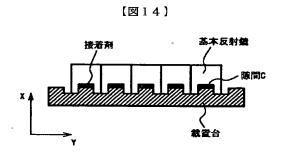




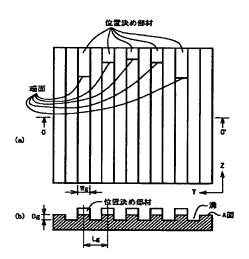








【図13】



THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

□ BLACK BORDERS
□ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
□ FADED TEXT OR DRAWING
□ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
□ SKEWED/SLANTED IMAGES
□ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
□ GRAY SCALE DOCUMENTS
□ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
□ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER: ____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)